

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 01-120874

(43)Date of publication of application : 12.05.1989

(51)Int.Cl.

H01L 31/10

H01L 33/00

(21)Application number : 62-278616

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 04.11.1987

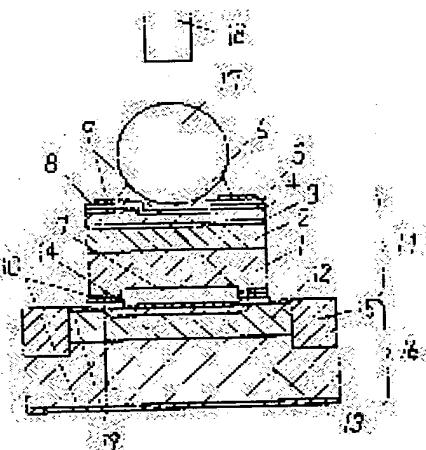
(72)Inventor : NAGAO SHIGERU  
MATSUDA TOSHIO  
FURUIKE SUSUMU

## (54) SEMICONDUCTOR PHOTODETECTOR/LIGHT EMITTING DEVICE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To simultaneously provide characteristics of a light emitting element having high performance to be required for a communication and characteristics of a photodetector by forming a structure in which an element having a light emitting function at an upper section, an element having a photodetecting function and formed in a laminar state at a lower section, and an external light can be detected by the photodetector through the active layer and a light radiating window of the light emitting element.

CONSTITUTION: A light emitting element 11 of III-V compound semiconductor crystal is employed as a light emission section, and a photodetector 16 of Si crystal is employed as a photodetection section. They are adhered integrally in a laminar state as upper and lower layers to provide both light emitting and photodetecting functions to photodetect by the photodetector 16 through a light emitting window 6 of the element 11. That is, the element 11 is adhered by thermal press-bonding to the photodetector 16 at the contact of its outer periphery, and an SiO<sub>2</sub> film is employed to insulate the element 11 and the photodetector 16. In this case, the window 6 of the element 11 is disposed directly above the window of the photodetector 16. The adhering material employs Sn and Au. The adhered element is contained in a T0-18 header, and associated by wire bonding. A fine microlens 17 is placed on the top of the photodetector 16, thereby condensing irradiated optical beams. Such a device structure is employed to stably obtain extremely preferable light emitting and photodetecting characteristics.



**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## ⑯ 公開特許公報 (A) 平1-120874

⑯ Int.CI.  
H 01 L 31/10  
33/00識別記号  
厅内整理番号  
Z-7733-5F  
Z-7733-5F

⑰ 公開 平成1年(1989)5月12日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

## ⑯ 発明の名称 半導体受発光装置

⑰ 特願 昭62-278616

⑰ 出願 昭62(1987)11月4日

⑯ 発明者 長尾 茂 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内  
 ⑯ 発明者 松田 俊夫 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内  
 ⑯ 発明者 古池 進 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内  
 ⑰ 出願人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地  
 ⑰ 代理人 弁理士 中尾 敏男 外1名

## 明細書

1. 発明の名称  
半導体受発光装置

## 2. 特許請求の範囲

発光機能を有する素子部を上部に持ち、受光機能を有する素子部を下部に層状に形成し、前記発光素子部の活性層および発光窓を通じて、外光を前記受光素子部で受光可能な構造になした半導体受発光装置。

## 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野 本発明は、光通信用受発光素子のチップ構造に関するものである。

## 従来の技術

従来の光通信用受発光素子として、たとえば、発光素子に、発光ピーク波長入射  $820 \sim 880$  nmで、発光出力  $P_o \approx 5\text{mW}$ 、遮断周波数  $f_c = 30 \sim 60\text{MHz}$ 、G 150/125光ファイバで、ファイバ端出力  $P_f = 1.0 \sim 5.0\text{ }\mu\text{W}$ 程度の GaAs/As結晶を用いた発光ダイオード(LED)

が実用化されている。

一方、光通信用受光素子には、受光径が、 $100 \sim 300\text{ }\mu\text{m}$ で、受光波長入射  $= 850\text{ nm}$ で、量子効率  $\eta = 50 \sim 70\%$ 、遮断周波数  $f_c = 100 \sim 300\text{ MHz}$ のSIを用いたPINフォトダイオードが実用化されている。

以上のような受光素子を用いて、伝送速度  $16 \sim 32\text{ Mbit/sec}$ 、伝送距離  $3\text{ km}$ 程度の光データリンクが市販されている。

発明が解決しようとする問題点

しかしながら、従来の光通信用受光素子には、次のような問題点が存在している。受光素子であるLEDは、ビデオ伝送などの映像信号を伝送する場合には、常に動作状態であるが、デジタル信号を伝送するようなデジタルリンクの場合には、一定時間の動作状態の後、LEDは、休止する時間を持つ。そこで、この休止時間には、LEDを逆に信号を受ける受光素子として使用することも多くなっている。

秀れた特性を持つ発光素子を受光素子として使用すると、受光感度が約-7~-10 dBと低く、実用レベルからは、ほど遠い。

一方、光通信用PINフォトダイオードは、受光素子としては、前述のような優秀な特性を有しているが、材質がシリコン(Si)であるため、発光素子として使用することはできない。つまり、1つの素子で、受光と発光との両者の特性を、実用レベルでその要求を満たすことは、極めて困難である。

#### 問題点を解決するための手段

本発明の半導体受発光装置は、発光部としてIII-V化合物半導体結晶による発光素子を用い、受光部としてSi結晶による受光素子を用い、これらを上下に層状に接着して一体化し、その発光素子の発光窓を通じて、前記受光素子で受光する発光機能と受光機能の両機能を有するものである。

#### 作用

本発明の受発光装置によると、発光素子とし

て、GaAlAs化合物半導体結晶を使用し、電流狭窄構造とグブルヘテロ構造を採用することにより、良好な光ファイバ端出力特性と高速応答性とを確保し、一方、受光素子としてSi-PINフォトダイオードを用い、この上部の受光窓に、GaAlAs発光ダイオードを接着し、発光ダイオードの発光窓を通じて、ファイバからの出射光を受光することにより、高い量子効率と高速応答性を実現できる。

また、これらGaAlAsとSiとでは、熱膨脹係数に大きな差はない(GaAlAs:  $6.17 \times 10^{-6}/\text{deg}$ , Si:  $2.5 \times 10^{-6}/\text{deg}$ )、接着されたデバイスの持つ温度特性は、十分安定している。

#### 実施例

本発明の受発光装置の実施例を第1図に概要断面図、第2図に具体例の断面図で示す。

まず、発光素子11の構造について説明する。液相成長により、N型GaAs基板上に5層の薄膜を成長した。

N<sub>1</sub>-GaAlAs基板層1 (AlAs混晶比X = 0.43~0.05) 上にN<sub>2</sub>-GaAlAsクラッド層2 (X = 0.20)、P<sub>1</sub>-GaAs活性層3 (厚さ1 μm)、P<sub>2</sub>-GaAlAsクラッド層4 (X = 0.35)、N<sub>3</sub>-GaAlAsコンタクト層5 (X = 0.17)を連続的に形成している。N<sub>3</sub>-GaAlAsコンタクト層5に直径80 μmの凹部6を選択的に作成し、その後P<sup>+</sup>拡散層8を1.5 μm形成した。N型GaAs基板を完全に除去した後、P側電極9とN側電極10を形成した。最後に発光窓の凹部の真下を選択的にエッチングし、N<sub>1</sub>-GaAlAs基板層7を深さ10 μmにわたって、φ200 μmの円形状の空洞領域7を形成した。

この発光ダイオードの発光波長は、880 nmである。チップ厚さは、約80 μmである。

次に受光素子16について述べる。高比抵抗層12 (ρ ≈ 3000 Ω·cm) を有するN型Si基板13に、チャンネルストッパー15とP<sup>+</sup>拡散

層14を形成し、SiO<sub>2</sub>膜による表面バッシベーションと無反射コート膜をこの上部に作成した。

このようにして得られたPIN型受光素子の受光径は300 μmで、チップサイズは、1.2 × 1.2 × 1.2 mmである。

以上のようにして作成した発光素子11と受光素子16とを外周辺の接触部で熱圧着により温度310°Cで接着した。発光素子と受光素子の絶縁には、SiO<sub>2</sub>膜を用いた。この時、発光素子の

発光窓が、受光素子の受光窓の真正にぐるよう考慮した。接着材には、SnとAuを用いている。この接着した素子をTO-18ヘッダーに入れ、ワイヤーボンドを行ない組立を行なった。受光素子の上部には、微小マイクロレンズ17を搭載し、発光した光ビームの集光を行なっている。

この素子をLEDとして動作させる場合には、第1図の発光部11の端子AとBを順バイアスし、素子の上部の部分のみを使用して、発光させ、光ファイバに発光した光を入射させる動きを

する。(図(b)参照)

一方、受光動作の場合には、下部の受光部16の端子CとDに逆バイアスを印加し、光ファイバから出射した光信号を上部に接着した発光部11(図(c)参照)を通じて、受光部に照射する構造となっており、両者は、絶縁膜を介して層状に接着されており、各々独立したデバイスとして使用できるものである。

本発明の実施例の素子では、発光モードとして動作させると、 $I_p = 100 \text{ mA}$ で発光出力  $P_o \approx 5 \text{ mW}$ 、 $G 150 / 125$ での光ファイバ端出力は、 $P_f \approx 20 \mu\text{W}$ 、遮断周波数は、 $f_c \approx 35 \text{ MHz}$ である。

一方、受光モードとして動作させると、逆バイアス電圧  $V_R = 10 \text{ V}$ で、遮断周波数は、 $f_c \approx 200 \text{ MHz}$ 、波長  $\lambda_p = 880 \text{ nm}$ での量子効率は、 $\eta \approx 40\%$ であった。この量子効率の値は、 $\text{GaAlAs LED}$ の活性領域を通じての値であり、活性領域での光の吸収が生じているが、これを差し引いても、かなりの高い量子効率が得られる。

5 ……  $N_1 - \text{GaAlAs}$  コンタクト層、6 ……凹領域(発光窓)、7 …… 円形状領域、8 ……  $P^+$ 拡散層、9 ……  $P$ 側電極、10 ……  $N$ 側電極、11 …… 発光素子、12 …… 高低抗層、13 ……  $N$ 型Si基板、14 ……  $P^+$ 拡散領域、15 …… チャンネルストッパー、16 …… 発光素子、17 …… 珠レンズ、18 …… 光ファイバ、19 …… 絶縁膜と表面保護膜。

代理人の氏名 井理士 中尾敏男 ほか1名

ている。

このようなデバイス構造を用いることにより、極めて良好な発光特性と受光特性が安定して得られた。

また、受光部と発光部が同一の場所に存在するため、従来困難とされていた、ファイバとの光軸調整が比較的容易であり、X方向、Y方向の微変動に対する許容値が大きくとれる。

#### 発明の効果

以上のように、本発明の受光装置によれば、通信用として要求される高性能な発光素子の特性と受光素子の特性とを同時に充たすことができ、広く利用できるものと期待される。

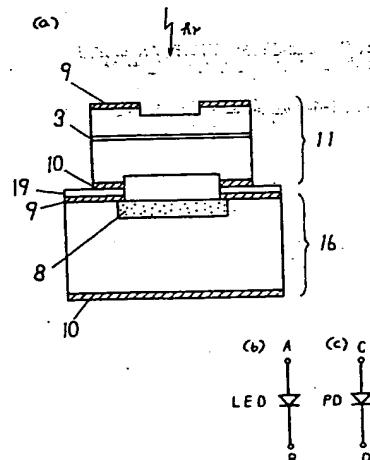
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明実施例の概要断面図、第2図は、本発明の受発光装置の一実施例断面図である。

1 ……  $N_1 - \text{GaAlAs}$  基板層、2 ……  $N_2 - \text{GaAlAs}$  クラッド層、3 ……  $P_1 - \text{GaAs}$  活性層、4 ……  $P_2 - \text{GaAlAs}$  クラッド層、

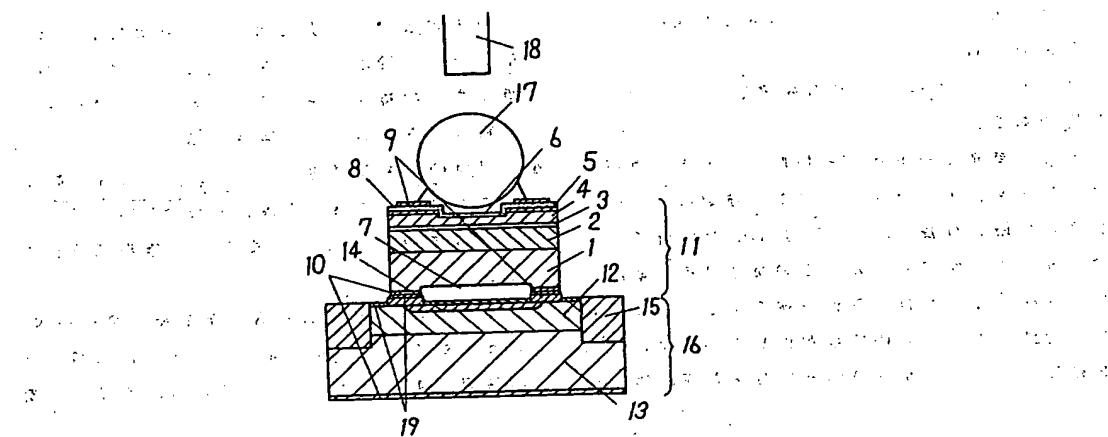
第1図

- 3 …… 活性層
- 8 ……  $P^+$ 拡散層
- 9 …… LEDP電極A
- 9 …… PD電極C
- 10 …… LEDN電極B
- 10 …… PD電極D
- 11 …… 発光部
- 16 …… 受光部
- 19 …… 絶縁膜



1 -	Ni-GaAlAs 基板層	11 -	発光部
2 -	N <sub>2</sub> -GaAlAs クラッド層	12 -	高抵抗層
3 -	P <sub>1</sub> -GaAs 活性層	13 -	N型 Si 基板
4 -	P <sub>2</sub> -GaAlAs クラッド層	14 -	P <sup>+</sup> 拡散領域
5 -	N <sub>2</sub> -GaAlAs コンタクト層	15 -	チャンネルストップ
6 -	凹面鏡(発光窓)	16 -	発光部
7 -	円形状領域	17 -	球レンズ
8 -	P <sup>+</sup> 拡散層	18 -	光ファイバ
9 -	P側電極	19 -	絶縁層と表面保護膜
10 -	N側電極		

第2図



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成6年(1994)3月4日

【公開番号】特開平1-120874

【公開日】平成1年(1989)5月12日

【年通号数】公開特許公報1-1209

【出願番号】特願昭62-278616

【国際特許分類第5版】

H01L 31/10

27/15 8934-4M

33/00 M 8934-4M

【F I】

H01L 31/10 Z 8422-4M

### 手 続 補 正 書

平成5年4月23日

特許庁長官 聞

1 事件の表示

平成62年特許願第278616号



2 発明の名称

半導体受発光装置

3 補正をする者

事件との関係 特許出願人  
住所 大阪府門真市大字門真1006番地  
名称 (682) 松下電器産業株式会社  
代表者 森下洋一

4 代理人

571  
住所 大阪府門真市大字門真1006番地  
松下電器産業株式会社内

氏名 (7242) 弁理士 小鏡治明  
(はか2名)  
(連絡先 電話(03)3434-9471 专利出所情報センター)

5 補正の対象

明細書の発明の詳細を説明の欄

### 6、補正の内容

(1) 明細書第3頁2行目の「受光感度が約-7~-1.0dBと低く」を「受光感度が低く」と補正します。

(2) 同第3頁17行目の「発光機能と受光機能の両機能」を「受光機能と発光機能の両機能」と補正します。

2

BEST AVAILABLE COPY